

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

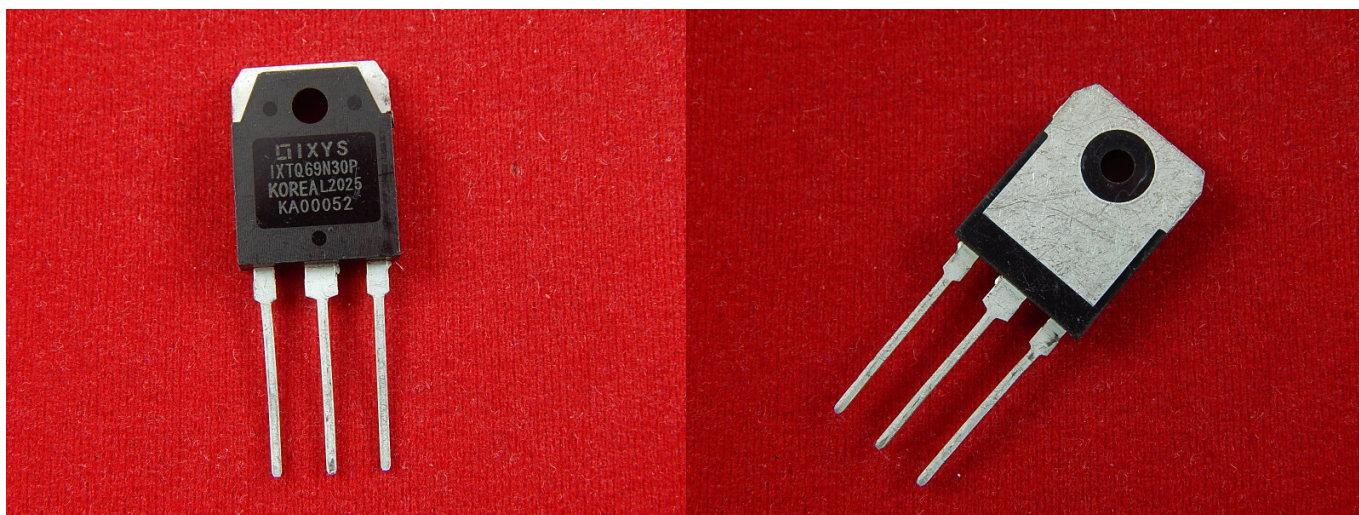
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16212

Цена в прайсе: 1232 тг.

Транзистор IXTQ69N30P, МОП-структура, N-канал, 300В, 69А, ТО-3P



Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми транзисторами с изолированным затвором, или МОП-транзисторами (англ. metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET).

Транзистор (transistor) - полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

Спецификация:

- Наименование прибора: IXTQ69N30P;
- Тип транзистора: MOSFET;
- Полярность: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность: 500W;
- Предельно допустимое напряжение сток-исток: 300V;
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток: 20V;
- Пороговое напряжение включения: 5V;
- Максимально допустимый постоянный ток стока: 69A;
- Максимальная температура канала: 150°C;
- Общий заряд затвора: 156nC;
- Время нарастания: 330ns;
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора: 0.049Ohm;
- Тип корпуса: ТО-3P

Подключение:

